磁介质

Lai Wei

2025年9月29日

1 磁介质的磁化

1.1 磁介质的磁化 相对磁导率

被磁化后的磁介质会激发附加磁场 B',从而影响介质内外的磁场分布。磁介质内的磁感应强度为

$$B = B_0 + B' \tag{1}$$

相对磁导率

$$\mu_r = \frac{B}{B_0} \tag{2}$$

相对磁导率 μ_r 的大小只与磁介质的性质有关,根据 μ_r 的大小将磁介质分成顺磁质、抗磁质和铁磁质三类。

- 1. 順磁质 μ_r 略大于 1, 即 $\mu_r \approx 1 + 10^{-4} > 1$
- 2. 抗磁质 μ_r 略大于 1, 即 $\mu_r \approx 1 10^{-5} < 1$
- 3. 铁磁质 $\mu_r >> 1$, 磁化后产生的磁场 B' 的方向与原磁场 B_0 的方向相同, 且 $B' >> B_0$

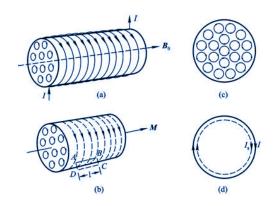
1.2 磁化强度和磁化电流

将磁介质中单位体积内分子磁矩的矢量和称为磁化强度,并用M来表示,即

$$M = \frac{\sum m_{\text{AF}}}{\Delta V} = \frac{\sum m + \sum \Delta m}{\Delta V}$$
 (3)

在国际单位制中,M 的单位为 $A \cdot m^{-1}$ 。

设有一"无限长"的载流直螺线管,管内充满均匀磁介质,电流在螺线管内激发匀强磁场。在此磁场中磁介质被均匀磁化,这时磁介质中各个分子电流平面将转到与磁场的方向相垂直。对磁介质的整体来说,未被抵消的分子电流是沿着柱面流动的,称为安培表面电流(或叫磁化面电流),用 I_s 表示。沿轴线单位长度上的磁化电流称为磁化电流密度,用 j_s 表示。于是,沿棒的轴线方向长为 L 的表面上,磁化电流的大小为 $I_s = j_s L$ 。介质被磁化的程度越大,介质表面的磁化电流越大。



对顺磁性物质,安培表面电流和螺线管上导线中的电流方向相同;对抗磁性物质,则 两者方向相反。

即当磁化强度的方向与介质表面平行时,磁介质表面磁化电流密度的大小等于该处磁化强度的大小,即

$$M = \frac{\sum \boldsymbol{m}_{\hat{\mathcal{H}}\vec{\mathcal{F}}}}{\Delta V} = \frac{j_s LS}{LS} = j_s \tag{4}$$

如果磁化强度的方向与介质表面不平行, 可以证明

$$\mathbf{j}_{s} = \mathbf{M} \times \mathbf{e}_{n} \tag{5}$$

式中 e_n 为磁介质表面的外法线单位矢量。该式表明,磁化强度M沿磁介质表面的切向分量等于介质表面的磁化电流密度。

可以证明:磁化强度 M 与磁化电流 I_s 之间的普遍关系为

$$\oint_{L} \boldsymbol{M} \cdot d\boldsymbol{L} = \sum I_{s} \tag{6}$$

2 有磁介质存在时的安培环路定理和高斯定理

2.1 有磁介质存在时的安培环路定理 磁场强度

有磁介质存在时,空间任意一点的磁感应强度 B 应由导线中的传导电流 I_0 和磁介质表面的磁环电流 I_s 共同产生,因此有磁介质存在时,磁场的安培环路定理应写成

$$\oint_{L} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{L} = \mu_0 \left(\sum I_0 + \sum I_s \right) \tag{7}$$

式中, $\sum I_0$ 是穿过闭合回路 L 所围面积的传导电流的代数和, $\sum I_s$ 时磁化电流的代数和。

如果将磁化强度 M 与磁化电流 I_s 的普遍关系式6代入上式,则有

$$\oint_{L} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{L} = \mu_{0} \left(\sum I_{0} + \oint_{L} \mathbf{M} \cdot d\mathbf{L} \right)$$
(8)

或写为

$$\oint_{L} \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) \cdot d\mathbf{L} = \sum I_0 \tag{9}$$

引入一个新的辅助物理量, 称为磁场强度, 用 H 表示, 并定义

$$\boldsymbol{H} = \frac{\boldsymbol{B}}{\mu_0} - \boldsymbol{M} \tag{10}$$

则式9可写为

$$\oint_{L} \boldsymbol{H} \cdot d\boldsymbol{L} = \sum I_{0} \tag{11}$$

式11称为有磁介质时的安培环路定理,它表明磁场强度 H 沿任一闭合回路 L 的线积分(或环流)等于通过该回路 L 所围成面积的传导电流的代数和。

2.2 磁介质的磁化特性

在各向同性的磁介质内部,任意一点的磁化强度 M 和磁场强度 H 成正比,即

$$\boldsymbol{M} = \chi_m \boldsymbol{H} \tag{12}$$

式中 χ_m 为比例系数,称为介质的<u>磁化率</u>,对于顺磁质, $\chi_m > 0$,表明顺磁质中 M 和 H 的方向相同;对于抗磁质, $\chi_m > 0$,表明抗磁质中 M 和 H 的方向相反。

于是

$$\boldsymbol{B} = \mu_0 (1 + \chi_m) \boldsymbol{H} = \mu_0 \mu_r \boldsymbol{H} = \mu \boldsymbol{H}$$
(13)

式中

$$\mu_r = 1 + \chi_m, \quad \mu = \mu_0 \mu_r \tag{14}$$

 μ_r 和 μ_0 分别称为磁介质的相对磁导率和绝对磁导率(有时也简称为磁导率)。

对于真空中的磁场,由于 M=0,则 $\chi_m=0$, $B=\mu_0 H$,这表明真空的相对磁导率 $\mu_r=1$ 。

2.3 有磁介质存在时的高斯定理

$$\oint_{S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \tag{15}$$